

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-162684

(43)Date of publication of application : 21.06.1996

(51)Int.Cl. H01L 39/22

(21)Application number : 06-301813

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing : 06.12.1994

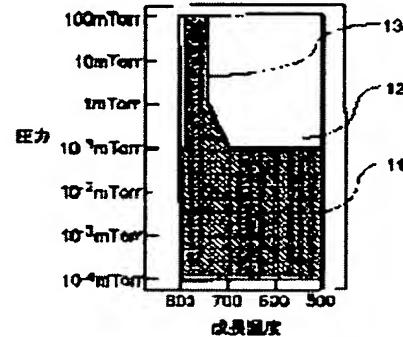
(72)Inventor : HIRATANI MASAHIKO
IMAGAWA KAZUSHIGE

(54) OXIDE ELEMENT AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To give the conditions of a temperature and a pressure for forming a thin film capable of growing in the orientation relation of a cube on cube in which an SrTiO₃ layer is on an MgO plane (001) in a board structure in which the SrTiO₃ layer is formed on a single crystalline surface of the MgO (001).

CONSTITUTION: An orientation of cube on cube is obtained on a hatched temperature-pressure area 11, an orientation (110) is mainly grown in a region 12, and an orientation (111) is mainly grown in a region 13. Accordingly, a low-cost perovskite structure board having a large area is given with suitable thin film growth of an oxide superconductor, a ferroelectric element, etc.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(10) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-162684

(43) 公開日 平成8年(1996)6月21日

(51) Int.Cl.
H01L 39/22類別記号
ZAA G

P I

技術表示箇所

審査請求 未請求 汎求項の数? 0L (全 6 项)

| | | | |
|-----------|-----------------|----------|--|
| (21) 出願番号 | 特願平6-301813 | (71) 出願人 | 000005108 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 |
| (22) 出願日 | 平成6年(1994)12月6日 | (72) 発明者 | 平谷 正彦 東京都墨田区東向ヶ丘1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内 |
| | | (72) 発明者 | 今川 一誠 東京都墨田区東向ヶ丘1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内 |
| | | (74) 代理人 | 弁護士 小川 勝男 |
| | | | |

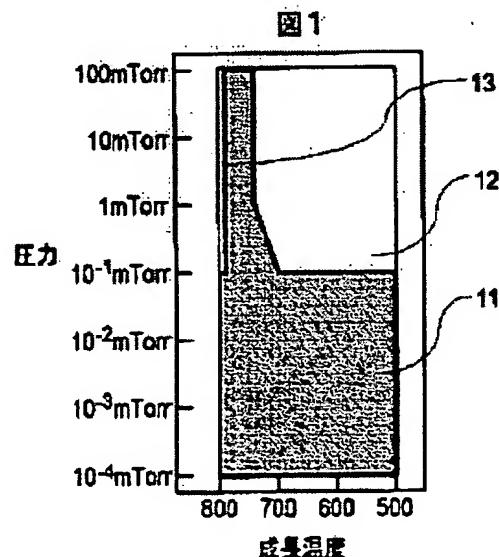
(54) 【発明の名前】 酸化物電子およびその製造方法

(57) 【要約】

【目的】 MgO (001) 単結晶面上に $SrTiO_3$ 層を形成する基板構造において、 $SrTiO_3$ 層が MgO (001) 面上にキューブ・オン・キューブの配向関係で成長し得る薄膜形成の温度と圧力の条件を与えることにある。

【構成】 ハッチの入った温度-圧力領域 (11) ではキューブ・オン・キューブの配向が得られ、領域 (12) では (11) 領域 (13) では (11) 配向が主として成長する。

【効果】 酸化物超電導体、強誘電体などの薄膜成長に好適で、かつ価格的に安価で大面积のペロブスカイト構造基板を与える。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】板状の酸化物マグネシウム (MgO) 単結晶上に単結晶からなる $SrTiO_3$ 層が形成された基板上に、酸化物層からなるソース電極、ドレイン電極および上記ソース、ドレイン電極間の上記基板上に絶縁膜を介してゲート電極を形成することを特徴とする酸化物素子。

【請求項 2】請求項 1に記載の酸化物素子において、上記ソース電極およびドレイン電極は、酸化物超電導体、導電性酸化物のうちいすれかの材料よりなることを特徴とする酸化物素子。

【請求項 3】請求項 1に記載の酸化物素子において、上記ゲート電極は、酸化物強誘電体、酸化物絶縁体、酸化物高誘電体のうちいすれかの材料よりなることを特徴とする酸化物素子。

【請求項 4】請求項 1に記載の酸化物素子において、上記 $SrTiO_3$ の Ti に Nb を 0.5 重量パーセント以内の範囲で添加したことを特徴とする酸化物素子。

【請求項 5】 MgO 単結晶板上に単結晶 $SrTiO_3$ を成長し、上記単結晶 $SrTiO_3$ 上に酸化物層からなるソース電極及びドレイン電極を形成し、上記ソース電極とドレイン電極間の上記単結晶 $SrTiO_3$ 上に絶縁膜を介してゲート電極を形成することを特徴とする酸化物素子の製造方法。

【請求項 6】請求項 5 の酸化物素子の製造方法において、上記単結晶 $SrTiO_3$ 層を成長させる温度は、 $SrTiO_3$ の {110} の型面が MgO の {001} の型面と平行であるような配向が消失すると同時に $SrTiO_3$ の {001} の型面が MgO の {001} の型面と平行である配向のみが得られ始める温度以上、かつ $SrTiO_3$ の {111} の型面が MgO の {001} の型面と平行であるような配向が現在し始める温度未満であることを特徴とする酸化物素子の製造方法。

【請求項 7】請求項 5 の酸化物素子の製造方法において、単結晶 $SrTiO_3$ は、パルスレーザ蒸着法、収束イオンビーム蒸着法、スパッタリング法のいずれかをもつてすることにより、上記 MgO 単結晶板上に形成することを特徴とする酸化物素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【達成上の利用分野】本発明は、単結晶よりなるチタン酸ストロンチウム 疲膜上に形成された酸化物超電導体、酸化物強誘電体、酸化物絶縁体、酸化物高誘電体よりなる素子およびその作製方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】チタン酸ストロンチウム ($SrTiO_3$) は酸化物超電導体薄膜や酸化物強誘電体薄膜を形成する基板として広く用いられている。これは基板および作製しようとする薄膜双方の結晶構造が同じペロブスカイト構造であることをを利用して、材料こそは異なるもの

の擬似ホモエピタキシャル成長とも言うべき類似の結晶構造からなる薄膜／基板構造を形成することで、より高品質の機能性薄膜を得ようとするものである。この例として、アプライド フィジックス レターズ、59 (1991年) 第3470頁 (Appl. Phys. Lett., 59 (1991), PP 3470) に見られる $Al/SrTiO_3/YBa_2Cu_3O_y/SrTiO_3$ 基板構造からなる電界効果型超電導素子を一例として挙げることができる。一方、ペロブスカイト構造を基板構造とする酸化物薄膜は、ペロブスカイト構造とは異なる塩化ナトリウム ($NaCl$) 型構造をとる酸化マグネシウム (MgO) 基板上にも形成し得ることが知られている。例えば、フィジカル レビュー、42 (1990年) 第10141頁 (Physical Review, 42 (1990), PP 10141) において、 $YBa_2Cu_3O_y/MgO$ 基板構造が報告されている。また、 MgO 基板上に直接 $YBa_2Cu_3O_y$ を形成する代わりに、 MgO 基板上に一旦ペロブスカイト構造の酸化物下地層を形成してその上に $YBa_2Cu_3O_y$ 酸化物を形成するという多層構造の例として、アプライド フィジックス レターズ、60 (1992年) 第3180頁 (Appl. Phys. Lett., 60 (1992), PP 3180) に見られる、 $YBa_2Cu_3O_y/SrTiO_3/MgO$ 構造を例として挙げることができる。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術の項において述べた、(1) $SrTiO_3$ 基板上に直接目的のペロブスカイト構造をとる酸化物層を形成する方法、(2) MgO 基板上に直接目的のペロブスカイト構造をとる酸化物層を形成する方法、(3) MgO 基板上に $SrTiO_3$ 中間層を介して目的のペロブスカイト構造をとる酸化物層を形成する方法、それぞれは以下に述べる問題点を有している。

【0004】まず、最初の $SrTiO_3$ 基板を用いる方法は従来技術の項で述べた通り、基板と同じペロブスカイト構造をとる機能性酸化物薄膜を形成するという目的では最も好ましい。しかし、 $SrTiO_3$ 基板そのものは、高価格と基板面積の制約という二つの大きな問題点を抱える。一般的な価格として、 $SrTiO_3$ 基板は厚さが 0.5 mm で 1 平方センチメートル当たり 5 千円以上と高い。さらに、基板上に素子などを形成する際には、高いスループットとそれに伴う素子単価の低減の観点から、基板面積は実用面積の範囲内で出来得る限り大きいことが望ましいのは言うまでもない。しかし、単結晶の育成技術上の制約から $SrTiO_3$ 単結晶基板の面積は最大で 200 mm 角に限定される。ペロブスカイト構造をとる単結晶基板としては $NdGaO_3$ も知られているが、その価格は $SrTiO_3$ 単結晶の 2 倍以上と高価である。

【0005】次に、SrTiO₃単結晶が抱える価格と面積の問題点を解決するために、ペロブスカイト構造のMgO単結晶を基板として用いる場合の問題点を説明する。MgO単結晶基板の価格は、厚さが0.5mmで1平方センチメートル当たり1.8千円前後とSrTiO₃単結晶基板の半額以下であり、さらにSrTiO₃単結晶基板の4倍の面積の4.0mm角の基板も容易に入手可能である。しかし、ペロブスカイト構造の酸化物薄膜を形成するための基板としては、擬似かモエビタキシを提供するSrTiO₃と比較して、MgO基板では完全なヘテロエビタキシが要求されるので、薄膜の結晶性が低下することは避けられない。従来技術の項で説明したMgO基板上にペロブスカイト構造をとるYBa₂Cu₃O₇薄膜を形成する例では、基板面と垂直な方向には薄膜は優先的な面配向関係を保つが、基板面に平行な面内では種々の方向に配向した結晶軸が混在して成長し、SrTiO₃基板を用いて得られる擬似かモエビタキシなどには、高配向の薄膜を成長させることは難しい。

【0006】最後に、MgO基板の価格、面積面での優位性と、SrTiO₃の擬似かモエビタキシを提供するという結晶性面での優位性の双方を有する解決策として、SrTiO₃層/MgO単結晶という基板構造を用いる場合を考える。しかしながら、従来技術の項で示したYBa₂Cu₃O₇薄膜/SrTiO₃層/MgO単結晶の例に見られるように、MgO単結晶上にSrTiO₃の単結晶を成長させるのは簡単ではない。MgO(001)単結晶基板上にSrTiO₃層を形成しようとすると、SrTiO₃薄膜の配向に関して、その(001)面が基板面と平行である関係に加えて(110)面が基板面と平行であるような関係も含まれることが報告されている。さらに、SrTiO₃層の(001)面が優先的にMgO基板面と平行である配向を得ようとするは、基板を摄氏1200度の高温で10時間熱処理してMgOの清浄結晶面を形成することが必要であると述べられている。典型的な薄膜形成温度が摄氏600度から800度であることを考えると、これよりも500度近く高い1200度という高温を4.0mm角の大面積基板に対して実行することは技術的にも価格的にも利点は少ない。

【0007】以上説明したように、従来の技術ではペロブスカイト構造の酸化物薄膜を作製するための単結晶基板として、低価格と大面積の双方に優れた好適な基板入手しがたい。

【0008】本発明の目的は、ペロブスカイト構造の酸化物薄膜を作製するための単結晶基板として、SrTiO₃単結晶薄膜層/MgO単結晶という構造を考案し、ペロブスカイト構造のSrTiO₃薄膜をNaCl型構造のMgO基板上へ成長させるというヘテロエビタキシの困難さを克服して、価格および面積の両面からペロブ

スカイト構造の酸化物薄膜作製に好適なSrTiO₃単結晶層/MgO単結晶構造の考案およびその作製方法を提供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するためには、以下のSrTiO₃単結晶層/MgO単結晶構造の作製条件を与えた。

【0010】既に説明したように、SrTiO₃層はMgO単結晶基板上に双方の単位胞を規定する結晶格子の一辺を共有して（いわゆるキューブオンキューブの関係）配向し得ることが知られている。ただし、同時に種々の配向が混在するためにはSrTiO₃の単結晶層が得られないことが大きな問題であることも上で説明した。SrTiO₃とMgOは格子の不整合（いわゆるミスマッチ）が7%と大きく、本来ならばキューブオンキューブの配向関係は期待できない。他の配向が混在しながらもキューブオンキューブの配向が一部含まれるのは、MgO単結晶表面上の微小な原子段差に沿って、SrTiO₃層がグラフオエビタキシするからだと言われている。通常、グラフオエビタキシには、基板表面上に蒸着される粒子の十分な表面運動エネルギーが要求される。言い換えると、付着する蒸着粒子にはグラフオエビタキシにとって必要なエネルギー的に安定であるような格子点を抵敵して接着するための運動エネルギーが要求される。つまり、十分な表面運動エネルギーが確保されるようなSrTiO₃層を作製する条件を見出せば、問題は解決するといつて良い。従来技術の項で挙げたMgO単結晶基板を摄氏1200度の高温で10時間熱処理する方法は、付着粒子がMgO表面上で表面運動する時に妨害となる原因を清浄表面を形成することで除外して大きな表面運動エネルギーを確保しようとする方法に他ならない。

【0011】そこで、十分な表面運動エネルギーが確保される結果としてMgO単結晶表面上にSrTiO₃の単結晶薄膜層が形成される条件が存在すると考え、これを調べた。具体的には、この目的を達成するためにMgO単結晶の(001)のいすれかの型面（以下では(001)面を代表面として説明する）上にSrTiO₃単結晶層の(001)のいすれかの型面（以下では(001)面を代表面として説明する）が、キューブオンキューブの関係で配向するようなSrTiO₃の薄膜作製中の温度-圧力条件を見出した。

【0012】

【作用】MgO単結晶の(001)面上に配向するSrTiO₃層の配向は、以下の理由により温度-圧力条件で変化する。

【0013】SrTiO₃層がMgO単結晶表面上の微小な原子段差に沿ってグラフオエビタキシすることを考えると、蒸着粒子の十分な表面運動エネルギーが確保されるような温度と圧力に関する薄膜作製条件が必ず存在す

るべきである。これは以下のように考えられる。

【0-0-14】まず、温度条件について考える。基板表面上での運動エネルギーを熱エネルギーによって供給する時には、グラフオエビタキシを与える最低温度が存在する。この温度よりも低い薄膜作製の温度条件では基板面上に蒸着される粒子に十分な表面運動エネルギーを熱エネルギーとして供給することができないために、薄膜にグラフオエビタキシを与えるような蒸着粒子と基板間での相互作用は期待されない。この温度よりも高い薄膜作製の温度条件では、十分な表面運動エネルギーが熱エネルギーとして供給される故に、グラフオエビタキシが期待される。薄膜作製の温度条件をさらに上昇させた場合を考える。グラフオエビタキシは熱平衡的に最も安定した配向ではなく、蒸着粒子の表面抵抗時間が影響する動力学的な効果と、蒸着粒子と基板間の熱エネルギー的に安定な相互作用との均衡によって達成される配向である。つまり、薄膜作製温度を上昇させるに伴って、グラフオエビタキシよりも安定な別の優先配向が発生することが期待される。例えば、結晶格子の最密充填構造面が基板面と平行に成長はじめると、温度が存在することが期待される。したがって、グラフオエビタキシを与える薄膜作製の温度条件は、グラフオエビタキシが開始する最低温度と別によりエネルギー的に安定な配向が開始する最高温度の範囲内に規定される。

【0-0-15】ここで最も問題となるのが、薄膜作製の温度条件の定義である。通常、薄膜作製の具体的な温度をすべての薄膜作製装置に共通の尺度として定義することは不可能である。なぜなら、基板を装着する加熱板の表面温度の測定方法が実際の表面を測る場合と加熱ヒータ近傍を測る場合とでは温度の定義が異なるし、装着する温度測定子の取付方法が単にねじ止めするだけの場合と熱シンクを介して接着する場合とでも温度定義には数十度の差がすぐに生じるなど、温度定義が個々によって異なるからである。しかし、たとえ具体的な温度の定義が異なっても、薄膜作製の温度条件が上昇するのに伴う温度配向からグラフオエビタキシそして温度的に安定な別の優先配向への変化は共通である。したがって、本発明の基盤となる装置で定義される温度に固定することなく、配向の変化が生じる相対的な温度によってもグラフオエビタキシに好適な温度範囲を制限することが出来る。

【0-0-16】次に、圧力条件について考える。基板表面上に飛行して蒸着される粒子は、粒子が空間を飛行するのに必要な運動エネルギーと粒子自体の励起状態を決定する内部エネルギーとを合わせ持つ。そして、飛行粒子が基板表面上に衝突した後は飛行粒子が保持していた運動および内部エネルギーは基板表面上での表面運動エネルギーに転化される。一方、飛行粒子の持つ運動と内部エネルギーは、飛行中の粒子間の衝突や雰囲気ガスとの衝突によって失われやすい。つまり、飛行粒子の飛行距離がその雰

囲気圧力下での平均自由行程よりも十分短いならばそのエネルギーは保持される。したがって、グラフオエビタキシに必要な表面運動エネルギーを飛行粒子が保持し続けるのに必要な最高の圧力値が存在する。この圧力よりも高い薄膜作製の圧力条件では、飛行粒子の持つ運動および内部エネルギーは雰囲気ガスとの衝突によって失われ、グラフオエビタキシを与えるだけの十分なエネルギーは蒸着粒子には保持されない。この圧力よりも低い薄膜作製の圧力条件では、十分大きなエネルギーが表面運動エネルギーに転化される結果、グラフオエビタキシが期待される。

【0-0-17】酸化物薄膜を作製するには、薄膜が分解しないための最低の酸化活性が雰囲気ガスに要求される。酸化活性は雰囲気ガスの種類に固有の物性値であるので、これを雰囲気ガスの圧力に換算して、雰囲気ガスの圧力は何トール以上であることが望ましいとは規定できない。雰囲気ガスとしては、純度空気、酸素(O₂)、二酸化窒素(N₂O)、一酸化窒素(N₂O)、オゾン(O₃)などの酸化性ガスおよびそのRF放電、DC放電、ECR放電、イオンビームなどによる活性状態が考えられる。雰囲気ガスが上記の酸化性ガスと不活性ガスの混合ガスである場合には、飛行粒子はすべてのガス分子と衝突し散乱されるので全体の圧力でもって雰囲気ガスの圧力とみなされる。

【0-0-18】以上のグラフオエビタキシを与える薄膜作製の温度と圧力の条件は、独立した条件ではなく温度と圧力の二つの変数で構成される二次元のグラフ上で地図化される。つまり、グラフオエビタキシに必要な粒子の表面運動エネルギーは温度と圧力のいずれかあるいは双方から同時に供給され得るので、例えば、温度条件の最低および最高温度は圧力とともに変化することが期待される。さらに、配向の温度および圧力依存の傾向は薄膜作製法には依存しない。グラフオエビタキシ条件を地図化し得る条件の範囲内で薄膜を形成することが可能な形態であれば、本発明による条件を適用することができる。

【0-0-19】MgO(0-0-1)基板面上にSrTiO₃薄膜がキューブオンキューブに配向するためには、MgO(0-0-1)面の格度を規定する必要がある。育成された単結晶の塊に対してX線回折などで方位を決定した後、これをもとにMgO(0-0-1)結晶面を切出す。もちろん、極めて正確に(0-0-1)結晶面が基板面と一致することが好ましく、さらに、極端な例として5度以上結晶面が基板面と変位すれば基板表面の実質的な結晶面が規定できなくなりキューブオンキューブの配向は期待されない。この両者の中庸からMgO(0-0-1)面と基板平面との角度はプラスマイナス2度以内であることが望ましい。

【0-0-20】以上説明したSrTiO₃薄膜のMgO(0-0-1)単結晶面上への成長に関する作用は、薄膜成長の観点から性質がほとんど変わらないNbを0、5重

量%以内の範囲で添加したSrTiO₃薄膜についても全く同様に適用される。

【0021】

【実施例】本発明を以下の実施例にもとづいて説明する。

【0022】(実施例1) MgO(001)面が基板平坦面となす角度がプラスマイナス0°、5度以内である25mm角のMgO単結晶板上に、バルスレーザ照射法を用いてSrTiO₃薄膜を作製した。光源には波長248nmのエキシマレーザを用い、ターゲットにはSrTiO₃の単結晶を用いた。薄膜成長の温度条件は摄氏50度から摄氏80度、圧力条件は1/10000ミリトルの範囲で変化させた。成長温度はMgO単結晶板を接着する加熱板上に致ミリ角の熱シンクを介して固定した直徑0.5mmのシース熱電対を用いて校正した値で定義した。酸化性ガスとして酸素を用い、1/1000ミリトル以下の圧力では残留ガスのみを用いる意図的には酸素を導入しなかった。

【0023】この成長温度と圧力条件の範囲で、X線回折によりSrTiO₃薄膜の配向を調べた結果を図1に示す。ハッチ入りで示した条件の領域(1.1)では、キューブオンキューブの配向のみが観察された。圧力が1/10ミリトル(mTorr)以下では温度にかかわりなく摄氏50度以上摄氏80度以下の温度条件でキューブオンキューブの配向のみが観察された。温度が摄氏74度以上摄氏80度未満では圧力にかかわりなく1/10ミリトル以下の圧力でキューブオンキューブの配向のみが観察された。(温度、圧力)の条件が(摄氏74度、1ミリトル)と重なる直線よりも高温かつ低圧側ではキューブオンキューブの配向のみが観察された。温度が摄氏80度で圧力が1/10ミリトル以下かつ1/10ミリトルよりも高い領域(1.3)では、最稠密面であるSrTiO₃の(111)面がMgO(001)面と平行である配向が優先配向で同時にキューブオンキューブの配向も混在した。残りの領域(1.2)では、SrTiO₃の(110)面がMgO(001)面と平行である配向が有力で、キューブオンキューブの配向も観察された。

【0024】なお、Nbを0.005重量%から0.5重量%の範囲で添加した薄膜についても図1と全く同じ結果が得られた。

【0025】(実施例2) MgO(001)面が基板平坦面となす角度がプラスマイナス1°、5度以内である10mm角のMgO単結晶板上に、収束イオンビーム照射法を用いてSrTiO₃薄膜を作製した。12kV-8mAの出力で発生した電子ビームを3つの磁界レンズを用いてSrTiO₃単結晶ターゲット上に収束した。ターゲット上での電子線のスポット径は約0.5ミリメートルであった。薄膜成長の温度条件は摄氏50度から

摄氏80度、圧力条件は1/10000ミリトルから1/10ミリトルの範囲で変化させた。成長温度はMgO単結晶板を接着する加熱板上に致ミリ角の熱シンクを介して固定した直徑0.5mmのシース熱電対を用いて校正した値で定義した。酸化性ガスとして酸素を用い、マスフロコントローラでガス流量をオレフイスを用いて排気速度を同時に制御して目的の圧力を達成した。この温度と圧力条件の範囲で、X線回折によりSrTiO₃薄膜の配向を調べた結果、すべての条件でキューブオンキューブの配向のみが観察された。

【0026】(実施例3) MgO(001)面が基板平坦面となす角度がプラスマイナス2°、0度以内である40mm角のMgO単結晶板上に、スパッタリング法を用いてNbを0.5重量%添加したSrTiO₃(以下Nb: SrTiO₃と記す)薄膜を作製した。ターゲットには焼結体ターゲットを用いた。薄膜成長の温度条件は摄氏450度から摄氏770度の範囲で変化させた。圧力条件が50ミリトルから10ミリトルの範囲ではRFマグネットロンスパッタリング法で、1ミリトルから5/10ミリトルの範囲ではマグネットロン型ECRスパッタリング法で薄膜を作製した。成長温度は装置構造の制約から加熱ヒータから致ミリ角離れた場所に設置した熱電対の指標で定義したので、基板面上の温度はこれよりも5度から10度高いと思われる。放電ガスにはアルゴンと酸素の6対4比率の混合ガスを用いた。

【0027】このヒータ温度と圧力条件の範囲でX線回折によりNb: SrTiO₃薄膜の配向を調べた結果を図2に示す。ハッチ入りで示した条件の領域(2.1と2.2)では、キューブオンキューブの配向のみが観察された。圧力が1/10ミリトル(mTorr)以下では温度にかかわりなくNb: SrTiO₃の(110)面がNb: SrTiO₃の(111)面と平行である配向が優先配向で同時にキューブオンキューブの配向のみが観察された。温度が摄氏75度以上770度以下で、圧力が50ミリトル以下かつ1/10ミリトルよりも高い領域(2.5と2.6)では、最稠密面であるNb: SrTiO₃の(111)面がNb: SrTiO₃の(001)面と平行である配向が優先配向で、同時にキューブオンキューブの配向も混在した。残りの領域(2.3と2.4)では、Nb: SrTiO₃の(110)面がNb: SrTiO₃の(001)面と平行である配向が有力で、キューブオンキューブの配向も観察された。

【0028】なお、Nbを0.005重量%および0.5重量%の範囲で添加したSrTiO₃薄膜およびNbを含まないSrTiO₃薄膜についても、図2と全く同じ温度と圧力条件に対する配向の依存性が観察された。

【0029】

【発明の効果】以上実施例において述べたごとく、本発明においては以下に述べる効果を有する。

【0030】 MgO (001) 結晶面が平坦面とプラスマイナス2, 0度以内で交差する MgO 単結晶板上に $SiTiO_3$ もしくは Nb を添加した $SiTiO_3$ 薄膜を形成する時には、薄膜形成中の温度と圧力を制御することで、キューブ オン キューブの配向のみが存在する単結晶薄膜を成長させることが可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】パルスレーザ蒸着法で作製した $SiTiO_3$ 薄膜の配向の圧力-成長温度の依存を示す図。

【図2】スパッタリング法で作製した Nb を添加した $SiTiO_3$ 薄膜の配向の圧力-ヒータ温度依存を示す図。

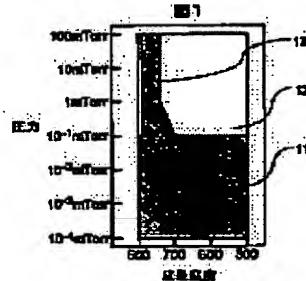
【符号の説明】

11···キューブ オン キューブ配向のみが成長する

領域、12···薄膜の(110)面が MgO (001)

1)面と平行である配向の他にキューブ オン キューブ配向も観察される領域、13···薄膜の(111)面が MgO (001)面と平行である配向の他にキューブ オン キューブ配向も観察される領域、21···キューブ オン キューブ配向のみが成長する領域、22···キューブ オン キューブ配向のみが成長する領域、23···薄膜の(110)面が MgO (001)面と平行である配向の他にキューブ オン キューブ配向も観察される領域、24···薄膜の(110)面が MgO (001)面と平行である配向の他にキューブ オン キューブ配向も観察される領域、25···薄膜の(111)面が MgO (001)面と平行である配向の他にキューブ オン キューブ配向も観察される領域、26···薄膜の(111)面が MgO (001)面と平行である配向の他にキューブ オン キューブ配向も観察される領域。

【図1】



【図2】

